
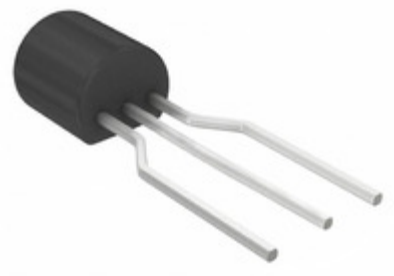








	<h2 style="color: red;">FJN3307RTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJN3307RTA</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p> <p>Datenblätter:  FJN3307RTA.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FJN3307RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	1500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	68 @ 5mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Verpackung	Tape & Box (TB)
Widerstand - Basis (R1)	22 kOhms
Widerstand - Emitterbasis (R2)	47 kOhms
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FJN3307RTA ist neu im Original, Suche FJN3307RTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJN3307RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJN3307RTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FJN3306RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3308RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3307RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3308RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>
 <p>FJN3307RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3308RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3309RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN3307RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 04026C104KAT2A	↔ ACMD-7614-QC1	⇒ AD605ARZ	D AP6682-R95MOGH0	⇒ BZX584C14
⊖ CGA5L2X8R2A154M160AD	⊕ CL21C150JB61PNC	D CT0603V150RFG	⇒ DS5022P-473MLD	⇒ FJN3302RTA
⊕ FJN3302RTA	⊖ FJN3303BU	⊕ FJN3303BU	↔ FJN3303RBU	⇒ FJN3303RBU
D FJN3305RTA	⊕ FJN3305RTA	⊖ FJN3307RTA	⊕ FJN3313R	⇒ FJN4302RTA
⇒ FJN4302RTA	↔ FJN4303R	⊕ FJN4305RTA	⊖ FJN4305RTA	⇒ FJN598JBBU
↔ FJN598JBBU	⇒ FJN598JCTA	D FJN598JCTA	⊕ FJN965TA	⊖ FJN965TA
⊕ FJNS4202R	D FJNS4206RTA	⇒ FJNS4206RTA	↔ IPA60R460CE	⇒ ISL6537ACRZ
⊖ LM4040DIM3X-1.2	⊕ LPC1785FBD208	↔ MAX4714ELT+T	⇒ MCH6661-TL-W	⇒ MOCD211-M
⊕ MV48-28-600H	⊖ NB2305A11HDR2G	⊕ PDTB113EK	D PKF4611SI	⇒ RFDIP2520080TM0T62
↔ SKN2M100/02	⊕ SPE0505S26RG	⊖ T221N08EOF	⊕ TL431DBVT	⇒ V20100SG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited